(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-8866

(P2002-8866A)

(43)公開日 平成14年1月11日(2002.1.11)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
H05B	33/14		H 0 5 B 33/14	B 3K007
C09K	11/06	6 1 0	C 0 9 K 11/06	610
		6 4 5		6 4 5

# 審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 9 頁)

(21)出願番号	特願2001-117824(P2001-117824)	(71)出願人	000003159
			東レ株式会社
(22)出願日	平成13年4月17日(2001.4.17)		東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号
		(72)発明者	小濱 亨
(31)優先権主張番号	特願2000-115393 (P2000-115393)		滋賀県大津市関山1丁目1番1号 東レ株
(32)優先日	平成12年4月17日(2000.4.17)		式会社滋賀事業場内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	北灣大輔
		(12,76,77	滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株
			式会社滋賀事業場内
		(72)発明者	
		(12/)[9]	※ では、
			式会社滋賀事業場内
		Fターム(参	考) 3K007 AB02 AB03 AB04 BA06 CA01
			CB01 DA01 DB03 EB00
		i	

## (54) 【発明の名称】 発光素子

# (57)【要約】

【課題】電気エネルギーの利用効率が高く、高輝度かつ 高色純度の発光素子を提供する。

【解決手段】正極と負極の間に発光物質が存在し、電気エネルギーにより発光する素子であって、該素子が下記一般式(1)で表される化合物を含むことを特徴とする発光素子。

# 【化1】

# $A \leftarrow B n$ (1)

(ここで、Aはスピロピフルオレン骨格、Bは蛍光性骨格、nは $1 \sim 4$  いずれかの自然数である。)

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】正極と負極の間に発光物質が存在し、電気 エネルギーにより発光する素子であって、該素子が下記 一般式(1)で表される化合物を含むことを特徴とする 発光素子。

# 【化1】

## $A \longrightarrow (1)$

(ここで、Aはスピロピフルオレン骨格、Bは蛍光性骨格、nは $1 \sim 4$  のいずれかの自然数である。)

【請求項2】前記一般式(1)のBが電子供与性窒素お\*10

\*よび/または炭素で構成される縮合環であることを特徴とする請求項1記載の発光素子。

【請求項3】前記一般式(1)のBがピロール骨格を含むことを特徴とする請求項2記載の発光素子。

【請求項4】前記一般式(1)で表される化合物がラセミ体であることを特徴とする請求項1記載の発光素子。

【請求項5】前記一般式(1)で表される化合物が下記一般式(2)で表されることを特徴とする請求項3記載の発光素子。

【化2】

(ここでR<sup>1</sup>~R<sup>26</sup>はそれぞれ同じでも異なっていてもよく、水素、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基、アルケニル基、シクロアルケニル基、アルキニル基、水酸基、メルカプト基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリールエーテル基、アリールチオエーテル基、アリール基、複素環基、ハロゲン、ハロアルカン、ハロアルケン、ハロアルキン、シアノ基、アルデヒド基、カルボニル基、カルボキシル基、エステル基、カルバモイル基、アミノ基、ニトロ基、シリル基、シロキサニル基、隣接置換基との間に形成される環構造、の中から選 30 ばれる。)

【請求項6】前記一般式(1)で表される化合物が発光 材料であることを特徴とする請求項1記載の発光素子。

【請求項7】マトリクスおよび/またはセグメント方式 によって表示するディスプレイであることを特徴とする 請求項1記載の発光素子。

#### 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電気エネルギーを 光に変換できる素子であって、表示素子、フラットパネ 40 ルディスプレイ、バックライト、照明、インテリア、標 識、看板、電子写真機、光信号発生器などの分野に利用 可能な発光素子に関する。

#### [0002]

【従来の技術】負極から注入された電子と正極から注入された正孔が両極に挟まれた有機蛍光体内で再結合する際に発光するという有機積層薄膜発光素子の研究が近年活発に行われている。この素子は、薄型、低駆動電圧下での高輝度発光、蛍光材料を選ぶことによる多色発光が特徴であり注目を集めている。

【0003】この研究は、コダック社のC. W. Tangらが有機積層薄膜素子が高輝度に発光することを示して以来(Appl. Phys. Lett. 51 (12)21, p. 913, 1987)、多くの研究機関が検討を行っている。コダック社の研究グループが提示した有機積層薄膜発光素子の代表的な構成は、ITOガラス基板上に正孔輸送性のジアミン化合物、発光層であるトリス(8ーキノリノラト)アルミニウム錯体、そして負極としてMg: Agを順次設けたものであり、10V程度の駆動電圧で1,000cd/m²の緑色発光が可能であった。現在の有機積層す膜発光素子は、上記の素子構成要素の他に電子輸送層を設けているものなど構成を変えているものもあるが、基本的にはコダック社の構成を踏襲している。

【0004】多色発光の中では緑色発光材料の研究が最も進んでおり、現在は赤色発光材料と青色発光材料において、耐久性に優れ十分な輝度と色純度特性を示すものが望まれ、特性向上を目指して鋭意研究がなされている。

【0005】青色発光材料としては、キノリノール誘導体金属錯体、オキサジアゾール誘導体、ジスチリルアリーレン誘導体、ジフェニルアントラセン誘導体などが挙げられる。最近では、スピロ構造の導入で結晶性を低下させたスピロ系材料も提案されている(特開平7-278537号公報、特開平11-273863号公報)。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来技術に用いられる青色発光材料(ホスト材料、ドーパント材料)には、発光効率が低く消費電力が高いものや、耐久性が50 低く素子寿命の短いものが多く、また、溶液状態では強

い蛍光強度を有していても薄膜状態では濃度消光やエキサイプレックスあるいはエキサイマー形成により蛍光強度が著しく減少し、発光素子に適用した際に高輝度発光が得られないものが多かった。

【0007】また上記スピロ系材料は、結晶性が低いために耐久性が高いと同時に、エキサイプレックスやエキサイマーを形成しないため蛍光強度は強いが、輝度が不十分であるという問題があった。

【0008】本発明は、かかる問題を解決し、電気エネルギーの利用効率が高く、高輝度かつ高色純度の発光素子を提供することを目的とするものである。

#### [0009]

【課題を解決するための手段】本発明は正極と負極の間に発光物質が存在し、電気エネルギーにより発光する素子であって、該素子が下記一般式(1)で表される化合物を含むことを特徴とする発光素子である。

[0010]

【化3】

# $A \leftarrow (B) n$ (1)

【0011】 (ここで、Aはスピロビフルオレン骨格、Bは蛍光性骨格、nは1~4のいずれかの自然数である。)

#### [0012]

【発明の実施の形態】本発明において正極は、光を取り 出すために透明であれば酸化錫、酸化インジウム、酸化 錫インジウム (ITO) などの導電性金属酸化物、ある いは金、銀、クロムなどの金属、ヨウ化銅、硫化銅など の無機導電性物質、ポリチオフェン、ポリピロール、ポ リアニリンなどの導電性ポリマなど特に限定されるもの でないが、ITOガラスやネサガラスを用いることが特 に望ましい。透明電極の抵抗は素子の発光に十分な電流 が供給できればよいので限定されないが、素子の消費電 力の観点からは低抵抗であることが望ましい。例えば3 00Ω/□以下のITO基板であれば素子電極として機 能するが、現在では10Ω/□程度の基板の供給も可能 になっていることから、低抵抗品を使用することが特に 望ましい。ITOの厚みは抵抗値に合わせて任意に選ぶ 事ができるが、通常100~300mmの間で用いられ ることが多い。また、ガラス基板はソーダライムガラ ス、無アルカリガラスなどが用いられ、また厚みも機械 的強度を保つのに十分な厚みがあればよいので、0.5 mm以上あれば十分である。ガラスの材質については、 ガラスからの溶出イオンが少ない方がよいので無アルカ リガラスの方が好ましいが、SiO2などのバリアコー トを施したソーダライムガラスも市販されているのでこ れを使用できる。ITO膜形成方法は、電子線ビーム 法、スパッタリング法、化学反応法など特に制限を受け るものではない。

【0013】負極は、電子を本有機物層に効率良く注入できる物質であれば特に限定されないが、一般に白金、

金、銀、銅、鉄、錫、亜鉛、アルミニウム、インジウ ム、クロム、リチウム、ナトリウム、カリウム、カルシ ウム、マグネシウムなどがあげられるが、電子注入効率 をあげて素子特性を向上させるためにはリチウム、ナト リウム、カリウム、カルシウム、マグネシウムまたはこ れら低仕事関数金属を含む合金が有効である。しかし、 これらの低仕事関数金属は、一般に大気中で不安定であ ることが多く、例えば、有機層に微量のリチウムやマグ ネシウム (真空蒸着の膜厚計表示で1 n m以下)をドー ピングして安定性の高い電極を使用する方法が好ましい 例として挙げることができるが、フッ化リチウムのよう な無機塩の使用も可能であることから特にこれらに限定 されるものではない。更に電極保護のために白金、金、 銀、銅、鉄、錫、アルミニウム、インジウムなどの金 属、またはこれら金属を用いた合金、そしてシリカ、チ タニア、窒化ケイ素などの無機物、ポリビニルアルコー ル、塩化ビニル、炭化水素系高分子などを積層すること が好ましい例として挙げられる。これらの電極の作製法 も抵抗加熱、電子線ビーム、スパッタリング、イオンプ 20 レーティング、コーティングなど導通を取ることができ れば特に制限されない。

【0014】本発明における発光物質とは、1)正孔輸送層/発光層、2)正孔輸送層/発光層/電子輸送層、3)発光層/電子輸送層、4)正孔輸送層/発光層/正孔阻止層/正孔阻止層/正孔阻止層/電子輸送層、6)発光層/正孔阻止層/電子輸送層そして、7)以上の組合わせ物質を一層に混合した形態のいずれであってもよい。即ち、素子構成としては、上記1)~6)の多層積層構造の他に7)のように発光材料単独または発光材料と正孔輸送材料や電子輸送材料を含む層を一層設けるだけでもよい。さらに、本発明における発光物質は自ら発光するもの、その発光を助けるもののいずれにも該当し、発光に関与している化合物、層などを指すものである。

【0015】正孔輸送層は正孔輸送性物質単独または二 種類以上の物質を積層、混合するか正孔輸送性物質と高 分子結着剤の混合物により形成され、正孔輸送性物質と してはN, N' -ジフェニル-N, N' -ジ (3 - メチ ルフェニル) -4, 4' -ジフェニル-1, 1' -ジア ミン、N, N'ージナフチルーN, N'ージフェニルー 4, 4'ージフェニルー1, 1'ージアミンなどのトリ フェニルアミン類、ビス(N-アリルカルバゾール)ま たはビス(N-アルキルカルバゾール)類、ピラゾリン 誘導体、スチルベン系化合物、ヒドラゾン系化合物、オ キサジアゾール誘導体やフタロシアニン誘導体、ポルフ ィリン誘導体に代表される複素環化合物、ポリマー系で は前記単量体を側鎖に有するポリカーボネートやスチレ ン誘導体、ポリビニルカルバゾール、ポリシランなどが 好ましいが、素子作製に必要な薄膜を形成し、正極から 50 正孔が注入できて、さらに正孔を輸送できる化合物であ

30

れば特に限定されるものではない。

【0016】発光層は発光材料(ホスト材料、ドーパント材料)により形成され、これはホスト材料とドーパント材料との混合物であっても、ホスト材料単独であっても、いずれでもよい。ホスト材料とドーパント材料は、それぞれ一種類であっても、複数の組み合わせであっても、いずれでもよい。ドーパント材料はホスト材料の全体に含まれていても、部分的に含まれていても、いずれであってもよい。ドーパント材料は積層されていても、分散されていても、いずれであってもよい。

【0017】発光材料としては下記一般式(1)に示す 化合物が好適に用いられる。

[0018]

【化4】

# $A \leftarrow B$ ) n (1)

【0019】ここで、Aはスピロビフルオレン骨格、Bは蛍光性骨格、nは1~4のいずれかの自然数である。

【0020】上記Aは材料の結晶性を低下させ均一な薄 膜形成能を発現させるための基本構造であり、上記Bは 高輝度発光を得るための発色団である。Bの具体例とし ては特に限定されるものではないが、ビフェニル、ター フェニル、クウオーターフェニル、ナフチル、フェナン スリル、アントラニル、ピレニル、スチリル、1,1-ジフェニルエテン-2-イル、インドリル、カルバゾリ ル、オキサチアゾリル、オキサゾリル、イミダゾリル、 オキサジアゾリルなどの置換基が挙げられる。中でも、 ナフチル、アントラニル、スチリル、1,1-ジフェニ ルエテンー2ーイルが好ましい。このように該Aと該B を適切に組み合わせることにより高輝度発光が実現され る。また、Aに対するBの数を適切に組み合わせること により共役長を調整して高色純度発光を、さらに薄膜形 成能や耐久性を高めることにより高輝度で高耐久性な発 光が実現される。

【0021】前記Bとしては、電子供与性窒素および/\*

\*または炭素で構成される縮合環が好適に用いられる。ここでいう電子供与性窒素とは、共役系に含まれない孤立電子対を有する窒素のことである。またここでいう炭素とはSP2混成軌道あるいはSP3混成軌道を有する炭素原子のいずれであってもよいが、上記縮合環が共役系であったほうが耐熱性と発光特性に優れるため、SP2混成軌道を有する炭素原子がより好適である。このような縮合環を導入することにより、発光材料として適当な電子親和力を付与することができ、耐久性を向上させることが可能となる。

【0022】さらに、より高輝度な発光を得るためには 蛍光量子収率が高い骨格が好ましいため、前記縮合環と してはピロール骨格を含む縮合環がより好適に用いられ る。このような縮合環の好適な例としては特に限定され るものではないが、1ーメチルインドールー2ーイル、 1ーエチルインドールー2ーイル、1ーフェニルインドールー2ーイル、1ーメチルー3ーフェニルインドールー2ーイル、1ーエチルー3ーフェニルインドールー2ーイル、1ーフェニルー3ーフェニルインドールー2ーイル、2、3ージフェニルインドールー1ーイル、カル バゾールー1ーイル、1ーメチルカルバゾールー3ーイル、1ーエチルカルバゾールー3ーイル、1ーフェニルカルバゾールー3ーイル、1ーフェニルカルバゾールー3ーイルなどの置換基が挙げられる。

【0023】また、前記一般式(1)で表される化合物 としてラセミ体が好適に用いられる。ラセミ体とは光学 異性体の混合物であり、結晶化速度が非常に遅いため、 素子の寿命を大幅に改善することができる。

【0024】上記一般式(1)で表される化合物として、高色純度かつ高輝度の青色発光を長時間にわたり安定して得るために、下記一般式(2)で表される化合物がより好適に使用される。

[0025]

【化5】

30

【0026】ここでR¹~R²6はそれぞれ同じでも異なっていてもよく、水素、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基、アルケニル基、シクロアルケニル基、アルキニル基、水酸基、メルカプト基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリールエーテル基、アリールチオエーテル基、アリール基、複素環基、ハロゲン、ハロアルカン、ハロアルケン、ハロアルキン、シアノ基、アルデヒド基、カルボニル基、カルボキシル基、エステル

基、カルバモイル基、アミノ基、ニトロ基、シリル基、 シロキサニル基、隣接置換基との間に形成される環構 造、の中から選ばれる。

【0027】これらの置換基の内、アルキル基とは例えばメチル基、エチル基、プロピル基、プチル基などの飽和脂肪族炭化水素基を示し、これは無置換でも置換されていてもかまわない。また、シクロアルキル基とは例えがシープロピル、シクロヘキシル、ノルボルニル、ア

ダマンチルなどの飽和脂環式炭化水素基を示し、これは 無置換でも置換されていてもかまわない。また、アラル キル基とは例えばベンジル基、フェニルエチル基などの 脂肪族炭化水素を介した芳香族炭化水素基を示し、脂肪 族炭化水素と芳香族炭化水素はいずれも無置換でも置換 されていてもかまわない。また、アルケニル基とは例え ばビニル基、アリル基、ブタジエニル基などの二重結合 を含む不飽和脂肪族炭化水素基を示し、これは無置換で も置換されていてもかまわない。また、シクロアルケニ ル基とは例えばシクロペンテニル基、シクロペンタジエ ニル基、シクロヘキセン基などの二重結合を含む不飽和 脂環式炭化水素基を示し、これは無置換でも置換されて いてもかまわない。また、アルキニル基とは例えばアセ チレニル基などの三重結合を含む不飽和脂肪族炭化水素 基を示し、これは無置換でも置換されていてもかまわな い。また、アルコキシ基とは例えばメトキシ基などのエ ーテル結合を介した脂肪族炭化水素基を示し、脂肪族炭 化水素基は無置換でも置換されていてもかまわない。ま た、アルキルチオ基とはアルコキシ基のエーテル結合の 酸素原子が硫黄原子に置換されたものである。また、ア リールエーテル基とは例えばフェノキシ基などのエーテ ル結合を介した芳香族炭化水素基を示し、芳香族炭化水 素基は無置換でも置換されていてもかまわない。また、 アリールチオエーテル基とはアリールエーテル基のエー テル結合の酸素原子が硫黄原子に置換されたものであ る。また、アリール基とは例えばフェニル基、ナフチル 基、ビフェニル基、フェナントリル基、ターフェニル 基、ピレニル基などの芳香族炭化水素基を示し、これは

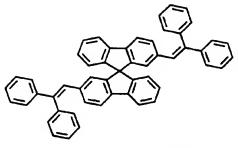
無置換でも置換されていてもかまわない。また、複素環 基とは例えばフリル基、チエニル基、オキサゾリル基、 ピリジル基、キノリル基、カルバゾリル基などの炭素以 外の原子を有する環状構造基を示し、これは無置換でも 置換されていてもかまわない。ハロゲンとはフッ素、塩 素、臭素、ヨウ素を示す。ハロアルカン、ハロアルケ ン、ハロアルキンとは例えばトリフルオロメチル基など の、前述のアルキル基、アルケニル基、アルキニル基の 一部あるいは全部が、前述のハロゲンで置換されたもの を示し、残りの部分は無置換でも置換されていてもかま わない。アルデヒド基、カルボニル基、エステル基、カ ルバモイル基、アミノ基には脂肪族炭化水素、脂環式炭 化水素、芳香族炭化水素、複素環などで置換されたもの も含み、さらに脂肪族炭化水素、脂環式炭化水素、芳香 族炭化水素、複素環は無置換でも置換されていてもかま わない。シリル基とは例えばトリメチルシリル基などの ケイ素化合物基を示し、これは無置換でも置換されてい てもかまわない。シロキサニル基とは例えばトリメチル シロキサニル基などのエーテル結合を介したケイ素化合 物基を示し、これは無置換でも置換されていてもかまわ ない。隣接置換基との間に形成される縮合環または脂肪 族環は無置換でも置換されていてもかまわない。

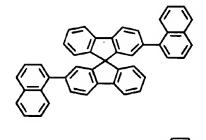
【0028】上記一般式(1)および(2)で表される 化合物の好適な例として、特に限定されるものではない が、具体的には下記のような構造が挙げられる。

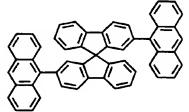
[0029]

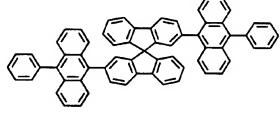
【化6】

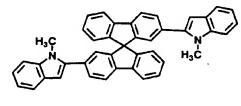


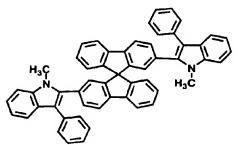












[0030]

【化7】

【0031】上記一般式(1)および(2)で表される 化合物は、いずれもドーパント材料としてもホスト材料 としても使用することができるが、該化合物は薄膜形成 性に優れ薄膜状態で強い蛍光を有するため、より好適に はホスト材料として用いることができる。

【0032】ドーピング量は、通常多すぎると濃度消光 現象が起きるため、通常ホスト材料に対して10重量% 以下で用いることが好ましく、更に好ましくは2重量% 以下である。ドーピング方法としては、ホスト材料との 共蒸着法によって形成することができるが、ホスト材料 と予め混合してから同時に蒸着しても良い。

【0033】また、ドーパント材料およびホスト材料 は、いずれもそれぞれ一種のみに限定する必要はなく、 本発明の化合物を複数混合して用いたり、あるいは既知 のドーパント材料およびホスト材料の一種類以上を本発 明の化合物と混合して用いてもよい。この場合の既知の ドーパント材料としてはイソベンゾフラン誘導体、ペリ レン誘導体、ジスチリルアリーレン誘導体、カルバゾー ル誘導体などが挙げられ、また既知のホスト材料として はキノリノール誘導体金属錯体、オキサジアゾール誘導 体、ジスチリルアリーレン誘導体、ジフェニルアントラ セン誘導体などが挙げられるが、これらに限定されるも

のではない。

【0034】また、ドーパント材料として上記蛍光性 (一重項発光) 材料だけでなく、燐光性 (三重項発光) 材料も好ましく用いられる。具体的には、ポルフィリン 白金錯体やトリス (2-フェニルピリジル) イリジウム 錯体、トリス {2-(2-チオフェニル) ピリジル {イ リジウム錯体、トリス |2-(2-ベンゾチオフェニ ル) ピリジル イリジウム錯体、トリス (2-フェニル ベンゾチアゾール) イリジウム錯体、トリス (2-フェ ニルベンゾオキサゾール) イリジウム錯体、ベンゾキノ リンイリジウム錯体などが挙げられるが、これらに限定 40 されるものではない。

【0035】本発明における電子輸送性材料としては、 電界を与えられた電極間において負極からの電子を効率 良く輸送することが必要で、電子注入効率が高く、注入 された電子を効率良く輸送することが望ましい。そのた めには電子親和力が大きく、しかも電子移動度が大き く、さらに安定性に優れ、トラップとなる不純物が製造 時および使用時に発生しにくい物質であることが要求さ れる。このような条件を満たす物質として、トリス(8 ーキノリノラト)アルミニウム錯体に代表されるキノリ ノール誘導体金属錯体、トロポロン金属錯体、フラボノ

30

14

ール金属錯体、ペリレン誘導体、ペリノン誘導体、ナフタレン、クマリン誘導体、オキサジアゾール誘導体、アルダジン誘導体、ビススチリル誘導体、ピラジン誘導体、フェナントロリン誘導体、シロール誘導体、キノキサリン誘導体などが挙げられるが特に限定されるものではない。これらの電子輸送材料は単独でも用いられるが、異なる電子輸送材料と積層または混合して使用しても構わない。

【0036】正孔阻止層は正孔阻止性物質単独または二種類以上の物質を積層、混合することにより形成され、正孔阻止性物質としてはフェナントロリン誘導体、シロール誘導体、キノリノール誘導体金属錯体、オキサジアゾール誘導体、オキサゾール誘導体などが好ましいが、正孔が負極側から素子外部に流れ出てしまい発光効率が低下するのを阻止することができる化合物であれば特に限定されるものではない。

【0037】本発明の(1)および(2)で表される化合物は上記正孔輸送層、発光層、電子輸送層、正孔阻止層のいずれにも好適に用いることができるが、薄膜状態で色純度が高く強度の大きい蛍光を有しているため、発光材料として発光層に適用することがより好ましい。

【0038】さらに、電子供与性窒素および/または炭素で構成される縮合環を含む場合は、正孔輸送性材料として正孔輸送層や、正孔輸送性ホスト材料として発光層に適用することも好ましい。

【0039】以上の正孔輸送層、発光層、電子輸送層、正孔阻止層に用いられる材料は単独で各層を形成することができるが、高分子結着剤としてポリ塩化ビニル、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリ (Nービニルカルバゾール)、ポリメチルメタクリレート、ポリブチルメタクリレート、ポリエステル、ポリスルフォン、ポリフェニレンオキサイド、ポリブタジエン、炭化水素樹脂、ケトン樹脂、フェノキシ樹脂、ポリサルフォン、ポリアシャン・カーン・カーの溶剤では樹脂や、フェノール樹脂、キシレン樹脂などの溶剤では樹脂や、フェノール樹脂、キシレン樹脂、石油樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂などの硬化性樹脂などに分散させて用いることも可能である。

【0040】発光物質の形成方法は、抵抗加熱蒸着、電子ビーム蒸着、スパッタリング、分子積層法、コーティング法など特に限定されるものではないが、通常は、抵抗加熱蒸着、電子ビーム蒸着が特性面で好ましい。層の厚みは、発光物質の抵抗値にもよるので限定することはできないが、1~1000nmの間から選ばれる。

【0041】綺麗な青色表示を行わせるためには、発光スペクトルができるだけ単一ピークであることが好ましいが、場合によっては他のピークとの重なりによって複数の極大点を有したり、ピークの裾に肩が現れることもある。本発明において、ピーク波長とは発光中心波長に 50

値する主ピークの波長であり、半値幅とはこれらピーク 全体において発光中心波長の高さの半分のところのピー ク幅であると定義している。

【0042】電気エネルギーとは主に直流電流を指すが、パルス電流や交流電流を用いることも可能である。電流値および電圧値は特に制限はないが、素子の消費電力、寿命を考慮するとできるだけ低いエネルギーで最大の輝度が得られるようにするべきである。

【0043】本発明におけるマトリクスとは、表示のた めの画素が格子状に配置されたものをいい、画素の集合 で文字や画像を表示する。画素の形状、サイズは用途に よって決まる。例えばパソコン、モニター、テレビの画 像および文字表示には、通常一辺が300μm以下の四 角形の画素が用いられるし、表示パネルのような大型デ ィスプレイの場合は、一辺がmmオーダーの画素を用い ることになる。モノクロ表示の場合は、同じ色の画素を 配列すればよいが、カラー表示の場合には、赤、緑、青 の画素を並べて表示させる。この場合、典型的にはデル タタイプとストライプタイプがある。そして、このマト リクスの駆動方法としては、線順次駆動方法やアクティ ブマトリックスのどちらでもよい。線順次駆動の方が構 造が簡単であるという利点があるが、動作特性を考慮し た場合、アクティブマトリックスの方が優れる場合があ るので、これも用途によって使い分けることが必要であ る。

【0044】本発明におけるセグメントタイプとは、予め決められた情報を表示するようにパターンを形成し、決められた領域を発光させることになる。例えば、デジタル時計や温度計における時刻や温度表示、オーディオ機器や電磁調理器などの動作状態表示、自動車のパネル表示などがあげられる。そして、前記マトリクス表示とセグメント表示は同じパネルの中に共存していてもよい

【0045】また本発明の発光素子はバックライトとしても好適に用いることができる。バックライトとは、主に自発光しない表示装置の視認性を向上させる目的に使用され、液晶表示装置、時計、オーディオ機器、自動車パネル、表示板、標識などに使用される。特に液晶表示装置、中でも薄型化が課題となっているパソコン用途のバックライトとしては、従来方式のものが蛍光灯や導光板からなっているため薄型化が困難であることを考えると本発明におけるバックライトは、薄型、軽量が特徴になる。

## [0046]

【実施例】以下、実施例および比較例をあげて本発明を 説明するが、本発明はこれらの例によって限定されるも のではない。

#### 【0047】実施例1

ITO透明導電膜を150nm堆積させたガラス基板 (旭硝子(株)製、15Ω/□、電子ビーム蒸着品)を

30×40mmに切断、エッチングを行った。得られた 基板をアセトン、"セミコクリン56"で各々15分間 超音波洗浄してから、超純水で洗浄した。続いてイソプ ロピルアルコールで15分間超音波洗浄してから熱メタ ノールに15分間浸漬させて乾燥させた。この基板を素 子を作製する直前に1時間UV-オゾン処理し、真空蒸 着装置内に設置して、装置内の真空度が1×10-5Pa 以下になるまで排気した。抵抗加熱法によって、まず正 孔輸送材料としてN, N'ージフェニルーN, N'ー (3-x+1)-1, 1'-57x=1-4,4'ージアミン(TPD)を50nmの厚さに蒸着し、 正孔輸送層を形成した。次に発光材料として下記に示す EM1を15nmの厚さに蒸着し、発光層を形成した。 次に2、9-ジメチル-4、7-ジフェニル-1、10 ーフェナントロリン (バソクプロイン) を35 n m の厚 さに蒸着して電子輸送層を形成し、最後にリチウムを 0.5 nm、銀を150 nm蒸着して負極を形成し、5 ×5mm角の素子を作製した。

[0048]

【化8】

16

【0049】この発光素子からは、発光ピーク波長が4 34 nm、最高輝度が342 c d/m²の高輝度かつ高 色純度の青色発光が得られた。

## 【0050】実施例2

10 正孔輸送層を形成せず、前記TPDと前記EM1を70 nmの厚さに共蒸着して発光層を形成した以外は実施例 1と同様にして発光素子を作製した。この発光素子から は、発光ピーク波長が452nm、最高輝度が426c d/m<sup>2</sup>の高輝度かつ高色純度の青色発光が得られた。

# 【0051】比較例1

発光材料として下記に示すEM2を用いた以外は実施例 1と同様にして発光素子を作製した。

[0052]

【化9】

【0053】この発光素子からは、発光ピーク波長が4 50 nm、最高輝度が50 c d/m²の低輝度な発光し か得られなかった。

#### 【0054】実施例3

正孔輸送材料としてEM1を、発光材料としてトリス (8-キノリノール) アルミニウム錯体 (Alq3) を 用いた以外は、実施例1と同様にして発光素子を作成し た。この発光素子からは良好な緑色発光が得られた。

#### 【0055】実施例4

ITO透明導電膜を150mm堆積させたガラス基板 (旭硝子 (株) 製、15 Ω/□、電子ビーム蒸着品)を 30×40mmに切断、フォトリソグラフィ法によって 300μmピッチ (残り幅270μm) ×32本のスト ライプ状にパターン加工した。ITOストライプの長辺 40 方向片側は外部との電気的接続を容易にするために1. 27 mmピッチ (開口部幅800μm) まで広げてあ る。得られた基板をアセトン、"セミコクリン56"で 各々15分間超音波洗浄してから、超純水で洗浄した。 続いてイソプロピルアルコールで15分間超音波洗浄し

てから熱メタノールに15分間浸漬させて乾燥させた。 この基板を素子を作製する直前に1時間UV-オゾン処 理し、真空蒸着装置内に設置して、装置内の真空度が5 30 ×10-4Pa以下になるまで排気した。抵抗加熱法によ って、まず前記TPDを100nm蒸着した。次に発光 材料として前記EM1を50nmの厚さに蒸着した。次 に厚さ50μmのコバール板にウエットエッチングによ って16本の250μmの開口部(残り幅50μm、3 00μmピッチに相当)を設けたマスクを、真空中で I TOストライプに直交するようにマスク交換し、マスク とITO基板が密着するように裏面から磁石で固定し た。そしてマグネシウムを50 nm、アルミニウムを1 50nm蒸着して32×16ドットマトリクス素子を作 製した。本素子をマトリクス駆動させたところ、クロス トークなく文字表示できた。

#### [0056]

【発明の効果】本発明は、電気エネルギーの利用効率が 高く、高輝度かつ高色純度の発光素子を提供できるもの である。